

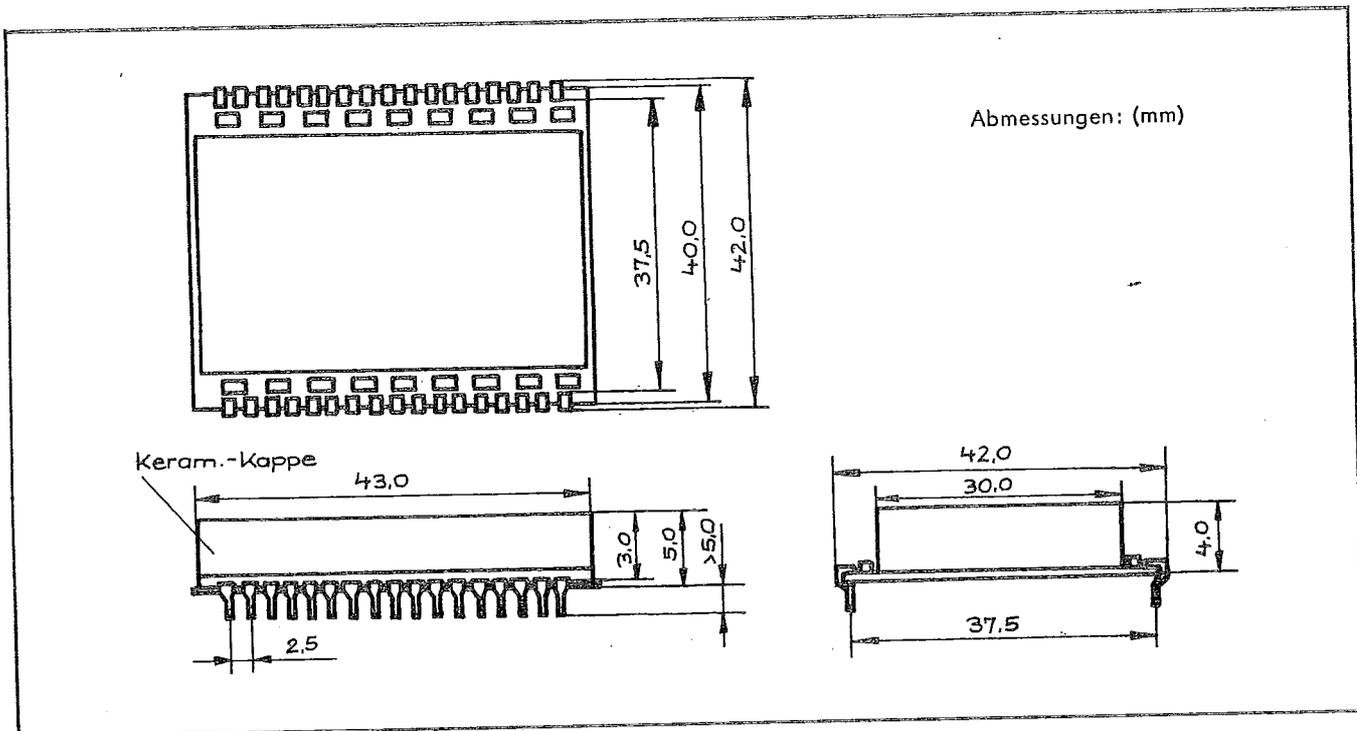
DRAM 1 Mbit-Hybridspeicher

16M 2164

Der Hybridschaltkreis ist ein hochintegrierter dynamischer Schreib-Lese-Speicher mit wahlfreiem Zugriff. Er verfügt über eine Speicherkapazität von 1 Mbit, die als Speicherblock von 128 kByte organisiert ist. Alle Ein- und Ausgänge sind TTL-kompatibel. Als Bauelemente werden die in nMOS-Technologie gefertigten U 2164-Chips verwendet. Folgende Betriebsarten sind möglich: READ, WRITE, READ-MODIFY-WRITE,

PAGE-MODE, REFRESH. Das Keramikgehäuse gewährleistet einen guten klimatischen und mechanischen Schutz der Schaltung. Die Betriebsspannung jedes Speicherchips U 2164 ist mit einem Keramik-Kondensator gestützt, zusätzlich sind zwei Tantal-Kondensatoren zur Abblockung der Betriebsspannung integriert.

Abmessungen: (mm)



Erzeugnisnummer: 4547.8-3479.41

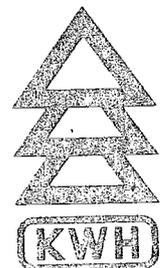
Typkurzzeichen: 4734

Betriebsbedingungen

Betriebsspannung: 5 V
 H-Eingangsspannung: $\geq 2,4$ V
 L-Eingangsspannung: $\leq 0,8$ V
 Betriebstemperaturbereich: 0 ... 70 °C

Kenngrößen

Betriebsstrom: ≤ 750 mA
 Ruhestrom: ≤ 60 mA
 Zugriffszeit von /RAS aus: ≤ 250 ns
 Zugriffszeit von /CAS aus: ≤ 150 ns



Abbildungen und Werte gelten nur bedingt als Unterlagen für Bestellungen. Rechtsverbindlich ist jeweils die Auftragsbestätigung. Änderungen vorbehalten.

